

2SA768, 2SA769

■シリコンPNPエピタキシャルメサ形トランジスタ

☆2SC1826～2SC1827とコンプリメンタリペアになります。

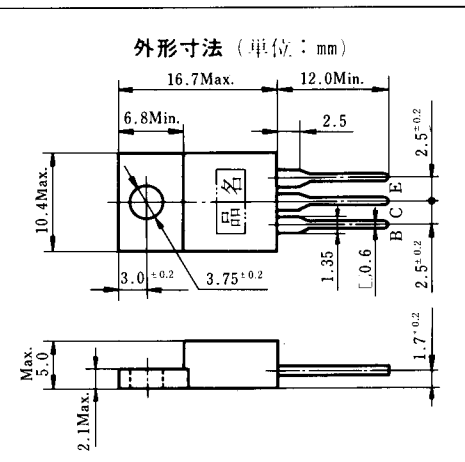
☆レジンモールドケース

○一般用

○通信産業用

■最大定格 (Ta=25°C)

項 目	記 号	2SA768	2SA769
コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	-60 V	-80 V
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	-60 V	-80 V
エミッタ・ベース電圧	V _{EB0}	-6 V	
コレクタ電流	I _C	-4 A	
ベース電流	I _B	-1 A	
許容コレクタ損失	P _C	30 W (フランジ温度25°C)	
接合部温度	T _j	150°C	
保存温度	T _{stg}	-55 ~ +150°C	



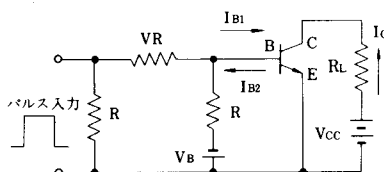
■電気的特性 (Ta=25°C)

項 目	記 号	試 験 条 件	2SA768	2SA769
最大コレクタシャ断電流	I _{CBO}		-1.0 mA	-1.0 mA
		V _{CB} =	-60 V	-80 V
最大エミッタシャ断電流	I _{EBO}	V _{EB} = -6 V	-1.0 mA	
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	I _C = -25 mA	-60 V	-80 V
直流電流増幅率	h _{FE}	V _{CE} = -4 V I _C = -1 A	40 Min.	
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C = -2 A I _B = -0.2 A	-1.0 V Max.	
シャ断周波数	f _T	V _{CE} = -10 V I _E = 0.2 A	10 MHz Typ.	

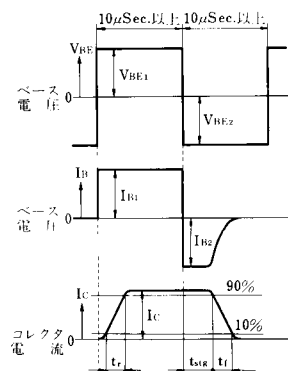
■代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V _{CC} (V)	R _L (Ω)	I _C (A)	I _{B1} (mA)	I _{B2} (mA)	t _r (μSec.)	t _{stg} (μSec.)	t _f (μSec.)
-6	3	-2	-300	300	1.0	0.4	0.15

スイッチング特性測定回路



測定条件



周囲温度と最大許容損失

